

### 关键指标

频率: 0.4~2.6GHz  
增益: 23dB@1GHz  
噪声系数: 0.8dB@1GHz  
1dB 压缩点输出功率: 21dBm  
电压/静态电流: +4V/76mA, +5V/108mA  
芯片尺寸: 1mm×1.25mm

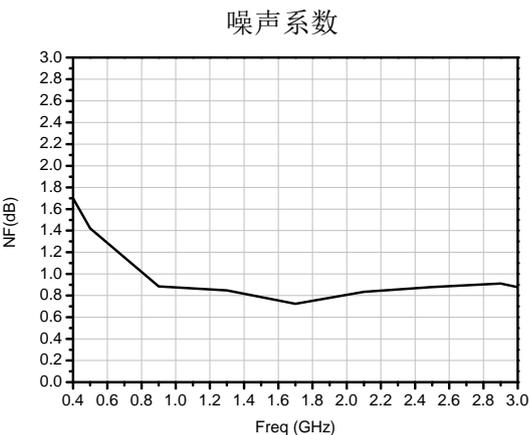
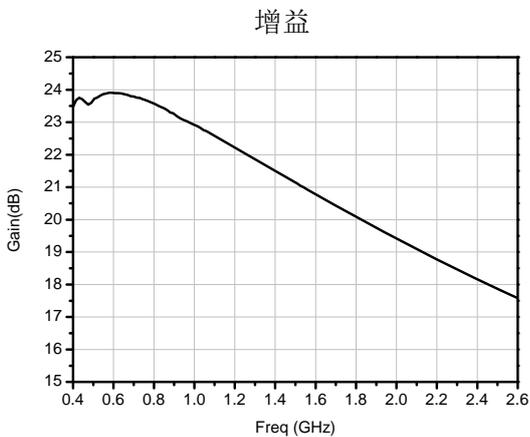
### 产品简介

该产品是一款 0.4~2.6GHz 型低噪声放大器芯片, 该芯片单电源供电, +4V 加电时, 静态电流为 76mA; +5V 加电时, 静态电流为 108mA, 射频输入输出端均有隔直电容。

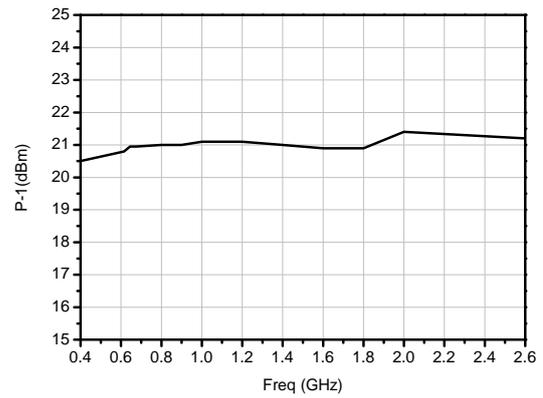
### 电性能 (TA=25°C, Vdd=+4V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.4~2.6		
增益(dB)	—	23@1GHz	—
增益平坦度(dB)	—	±3	—
输入驻波	—	1.4	—
输出驻波	—	1.6	—
噪声系数(dB)	—	0.8	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	21	—

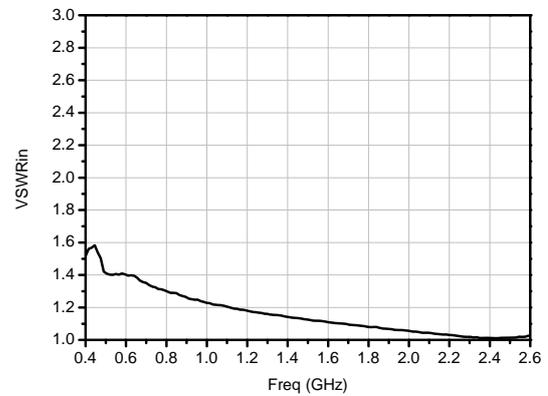
### 典型测试曲线 (+4V)



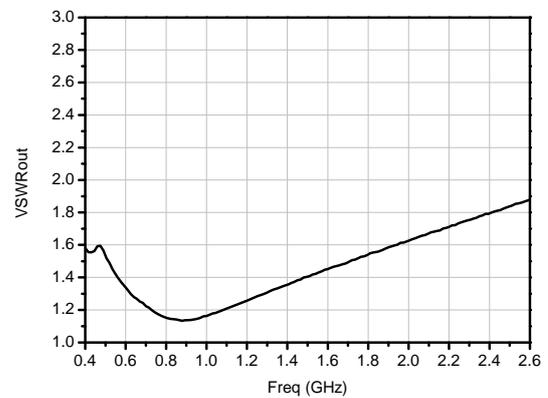
### 1dB 压缩点输出功率@4V



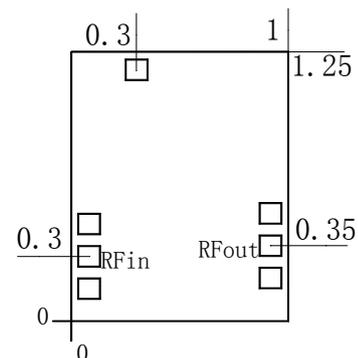
### 输入驻波



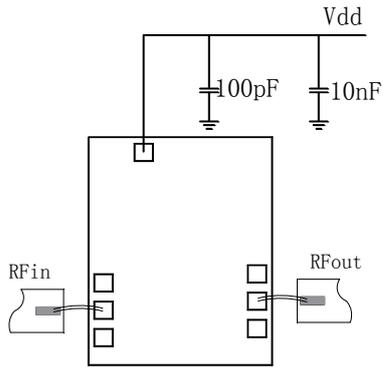
### 输出驻波



### 外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片输入输出端均有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。